

# Физика и техника полупроводников, 2018, том 52, выпуск 13

## Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Кулеев И.Г., Кулеев И.И., Бахарев С.М.

**Эффекты МакКарди в теплопроводности упруго анизотропных кристаллов в режиме кнудсеновского течения фононного газа**

1543

Середин П.В., Голощапов Д.Л., Золотухин Д.С., Кондрашин М.А., Леньшин А.С., Худяков Ю.Ю., Мизеров А.М., Арсентьев И.Н., Бельтюков А.Н., Leiste Harald, Rinke Monika

**Влияние буферного слоя  $\text{por-Si}$  на структуру и морфологию эпитаксиальных гетероструктур  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N/Si}(111)$**

1553

## Электронные свойства полупроводников

Абдинов А.Ш., Бабаева Р.Ф.

**Особенности подвижности электронов в слоистом полупроводнике  $n\text{-InSe}$**

1563

Усанов Д.А., Постельга А.Э., Калямин А.А., Шаров И.В.

**Измерение подвижности носителей заряда в арсениде галлия с помощью ближнеполевого сверхвысокочастотного микроскопа методом сверхвысокочастотного магнитосопротивления**

1570

Вейнгер А.И., Кочман И.В., Окулов В.И., Андрийчук М.Д., Паранчич Л.Д.

**Электронный парамагнитный резонанс электронов проводимости в кристаллах  $\text{HgSe}$**

1573

Emtsev V.V., Abrosimov N.V., Kozlovski V.V., Poloskin D.S., Oganessian G.A.

**Interaction rates of group-III and group-V impurities with intrinsic point defects in irradiated Si and Ge**

1578

## Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Ушаков В.В., Аминев Д.Ф., Кривобок В.С.

**Внутрицентровые излучательные переходы на примесных центрах тантала в теллуриде кадмия**

1579

## Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Ивакин Е.В., Киселёв И.Г., Никируй Л.И., Яворский Я.С.

**Оптические исследования теплопереноса в тонких пленках  $\text{PbTe} : \text{Bi}(\text{Sb})$**

1584

Феклистов К.В., Черков А.Г., Попов В.П., Федина Л.И.

**Перераспределение атомов отдачи эрбия и кислорода и структура тонких приповерхностных слоев кремния, созданных высокодозной имплантацией аргона через поверхностные пленки  $\text{Er}$  и  $\text{SiO}_2$**

1589

## Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Ушанов В.И., Чалдышев В.В., Преображенский В.В., Путято М.А., Семягин Б.Р.

**Диффузионное размытие квантовых ям  $\text{GaAs}$ , выращенных при низкой температуре**

1597

## Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Захарова И.Б., Елистратова М.А., Романов Н.М., Квятковский О.Е.

**Особенности электронной структуры агрегированных форм  $\text{ZnTPP}$  по данным оптических измерений и квантово-химических расчетов**

1601

## Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Басалаев Ю.М.

**Первопринципное исследование полупроводника  $\text{ZnSnSb}_2$**

1608

Ли Г.В., Астрова Е.В., Лихачев А.И.

**Влияние перекиси водорода на фотоанодирование  $n\text{-Si}$  в режиме пробоя**

1614

## Физика полупроводниковых приборов

Александров О.В., Агеев А.Н., Золотарев С.И.

**Накопление зарядов в МОП-структурах с поликремниевым затвором при туннельной инжекции**

1625

Тягинов С.Э., Макаров А.А., Kaczer B., Jech M., Chasin A., Grill A., Hellings G., Векслер М.И., Linten D., Grasser T.

**О влиянии параметров топологии транзистора с каналом в форме плавника на деградацию, вызываемую горячими носителями**

Куликов В.Б., Маслов Д.В., Сабиров А.Р., Солодков А.А., Дудин А.Л., Кацавец Н.И., Коган И.В., Шуков И.В., Чалый В.П. <b>nВn-фотодиод на основе InAsSb/AlAsSb-твердых растворов с длинноволновой границей 5 мкм</b>	1631
Хвостиков В.П., Сорокина С.В., Потапович Н.С., Левин Р.В., Маричев А.Е., Тимошина Н.Х., Пушный Б.В. <b>Фотоэлектрические преобразователи лазерного излучения (<math>\lambda=1064</math> нм) на основе GaInAsP/InP</b>	1636
Хвостиков В.П., Калиновский В.С., Сорокина С.В., Шварц М.З., Потапович Н.С., Хвостикова О.А., Власов А.С., Андреев В.М. <b>Фотоэлектрические AlGaAs/GaAs-преобразователи излучения тритиевых радиолуминесцентных ламп</b>	1641
Стрельчук А.М., Козловский В.В., Лебедев А.А. <b>Радиационное повреждение карбид-кремниевых диодов заряженными частицами высоких энергий</b>	1647
<b>Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур</b>	1651
Садовников С.И., Вовкотруб Э.Г. <b>Определение области термической стабильности размера и фазового состава наночастиц полупроводникового сульфида серебра</b>	1656
Семенов А.Н., Нечаев Д.В., Трошков С.И., Нащекин А.В., Брунков П.Н., Жмерик В.Н., Иванов С.В. <b>Особенности селективного роста наноколонн GaN на профилированных подложках с-сапфира различной геометрии</b>	1663
Кудряшов Д.А., Гудовских А.С., Баранов А.И. <b>Прецизионное химическое травление эпитаксиальных слоев GaP(NAs) для формирования монолитных оптоэлектронных приборов</b>	1668
Никитин С.Е., Бобыль А.В., Авезова Н.Р., Теруков Е.И. <b>Новые технологические подходы к созданию текстур и согласованию термического расширения в дизайне высокоэффективных кремниевых солнечных фотопреобразователей</b>	1675